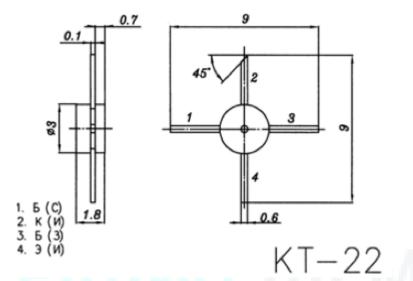


2T648A-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n генераторные. Предназначены для применения в генераторах и усилителях в диапазоне частот 1...12 ГГц в схеме с общей базой в составе гибридных интегральных микросхем. Транзисторы 2Т648А-2 бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. На крышку транзистора наносится условная маркировка: - две черные точки.



Тип прибора указывается на этикетке.

Масса бескорпусного транзистора не более 0,2 г.

Тип корпуса: КТ-22.

Технические условия: аА0.339.266ТУ.

Изготовитель - завод «Пульсар», г. Москва.

Основные технические характеристики транзистора 2Т648А-2:

- Рвых Выходная мощность на частоте f = 12 ГГц при Uкб = 12 В: не менее 40 мВт;
- Ку.р. Коэффициент усиления по мощности: 3 дБ;
- Ск Емкость коллекторного перехода: не более 1,5 пФ;
- Ікбо Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В: не более 1 мА;
- Икб тах Максимальное напряжение коллектор-база: 18 В;
- Uэбо max Максимальное напряжение эмиттер-база: 2 В;
- Ік тах Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 60 мА;
- Рк тах Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,42 Вт.
- Рк ср max Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,6 Вт.